

Silicon Diode

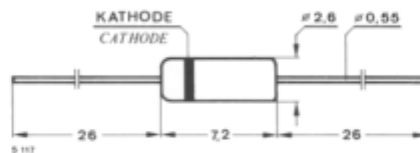
BA147/150

150V / 150mA

DATASHEET

OEM – Telefunken

Source: Telefunken Databook 1977

BA 147/...**Silizium-Diode**
Silicon diode**Anwendungen:** Allgemein**Applications:** General purpose**Abmessungen in mm**
Dimensions in mm

Normgehäuse
Case
51 A 2 DIN 41 880
JEDEC DO 7
Gewicht · Weight
max. 0,2 g

Absolute Grenzwerte
Absolute maximum ratings

Sperrspannung Reverse voltage	BA 147/25	U_R	25	V
	BA 147/50	U_R	50	V
	BA 147/100	U_R	100	V
	BA 147/150	U_R	150	V
	BA 147/230	U_R	230	V
	BA 147/300	U_R	300	V
Periodischer Durchlaßspitzenstrom Repetitive peak forward current		I_{FRM}	500	mA
Durchlaßstrom Forward current		I_F	150	mA
Sperrschichttemperatur Junction temperature		T_j	150	°C
Lagerungstemperaturbereich Storage temperature range		T_{stg}	-55...+150	°C

BA 147/ ...

Wärmewiderstand Thermal resistance

Min. Typ. Max.

Sperrschicht-Umgebung
Junction ambient

$l = 4 \text{ mm}$, $t_L = \text{konstant}$
constant

R_{thJA}

500 °C/W

Kenngrößen Characteristics

$t_j = 25^\circ\text{C}$, falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified

Durchlaßspannung
Forward voltage

$I_F = 50 \text{ mA}$

U_F

1 V

Sperrstrom
Reverse current

$U_R = 25 \text{ V}$	BA 147/25	I_R	500	nA
$U_R = 50 \text{ V}$	BA 147/50	I_R	500	nA
$U_R = 100 \text{ V}$	BA 147/100	I_R	1	μA
$U_R = 150 \text{ V}$	BA 147/150	I_R	1,5	μA
$U_R = 230 \text{ V}$	BA 147/230	I_R	2	μA
$U_R = 300 \text{ V}$	BA 147/300	I_R	3	μA

$t_j = 100^\circ\text{C}$

$U_R = 10 \text{ V}$	BA 147/25, BA 147/50	I_R	15	μA
$U_R = 50 \text{ V}$	BA 147/100	I_R	30	μA
$U_R = 100 \text{ V}$	BA 147/150	I_R	50	μA
$U_R = 150 \text{ V}$	BA 147/230	I_R	75	μA
$U_R = 200 \text{ V}$	BA 147/300	I_R	100	μA

BA 147/ ...